

## 描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

## 特征 / Features

$P_C$  大,  $h_{FE}$  高且特性好, 与 9015MG 互补。无卤产品。

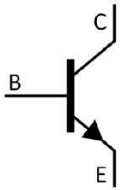
High  $P_C$  and  $h_{FE}$ , excellent  $h_{FE}$  linearity, complementary pair with 9015MG.HF Product.

## 用途 / Applications

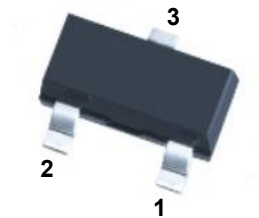
用于低电平、低噪声的前置放大器。

Low frequency, low noise pre-amplifier.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter      PIN 2 : Base      PIN 3 : Collector

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	A	B	C	D
$h_{FE}$ Range	60~150	100~300	200~600	400~1000
Marking	GJ6A	GJ6B	GJ6C	GJ6D

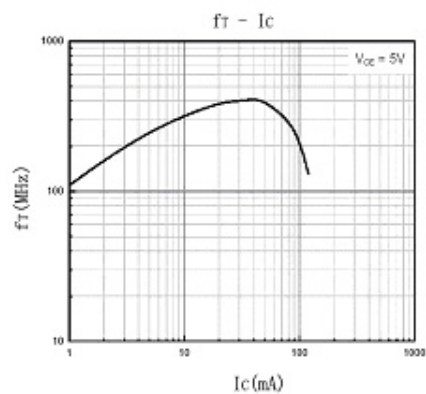
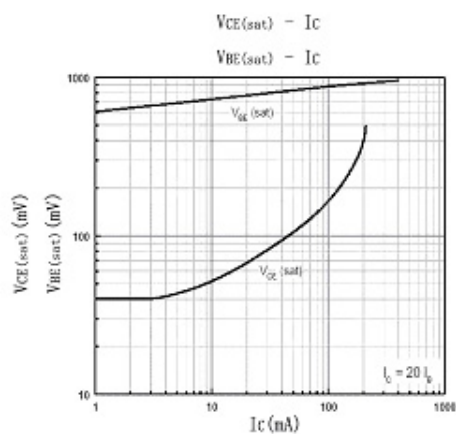
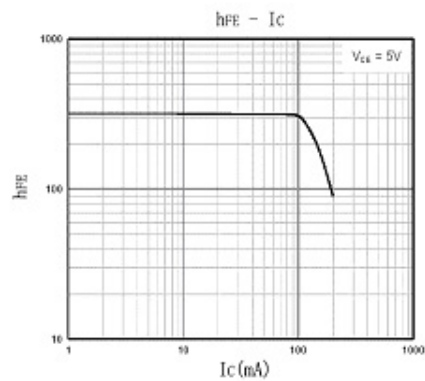
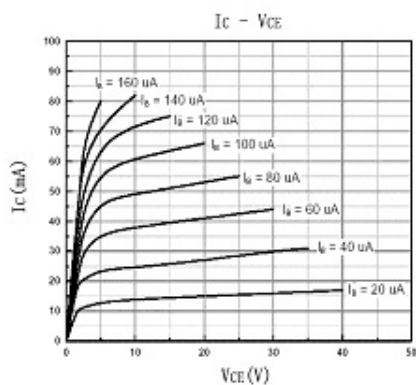
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	50	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	45	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Collector Current	$I_C$	100	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	400	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=0.1mA$ $I_E=0$	50			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	45			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=0.1mA$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50V$ $I_E=0$			0.05	μA
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			0.05	μA
DC Current Gain	$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	60		1000	
Collector-Emitter Saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$ $I_B=5.0mA$		0.14	0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100mA$ $I_B=5.0mA$		0.84	1.0	V
Base-Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=2.0mA$		0.63	0.7	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	150	270		MHz
Collector Output Capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	3.5	pF
Noise Figure	NF	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=-0.2mA$ $R_g=2.0K\Omega$ $f=1.0KHz$ $\Delta f=200Hz$		0.9	10	dB

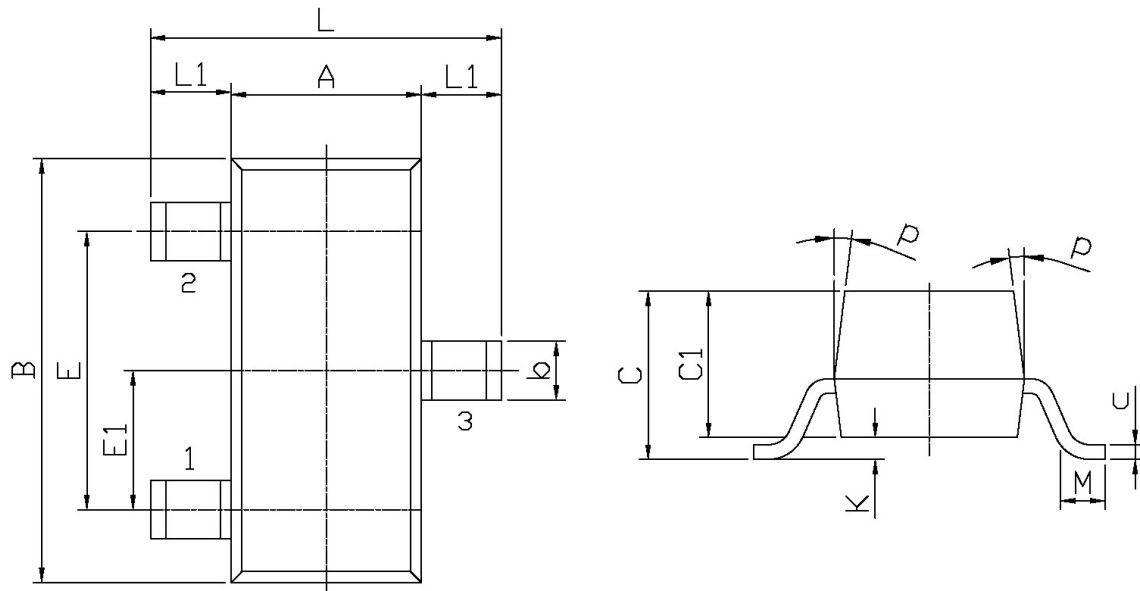
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

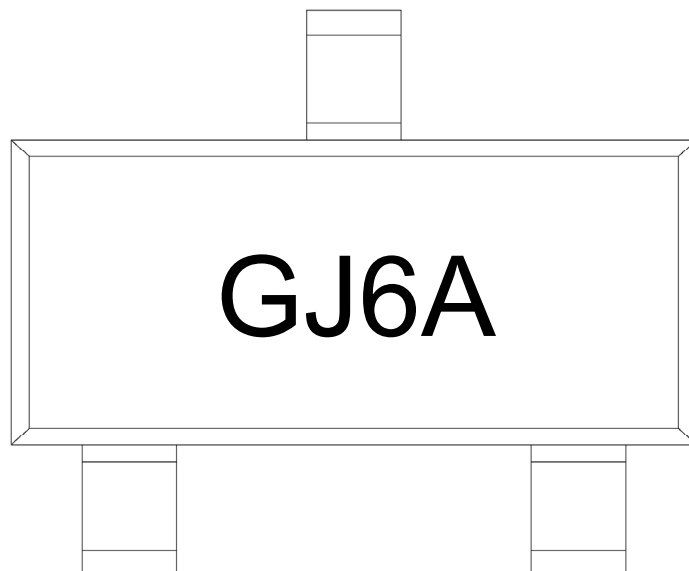
SOT-23

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

印章说明 / Marking Instructions



说明：

G： 为无卤产品代码

J6： 为型号代码

A： 为  $h_{FE}$  档次代码

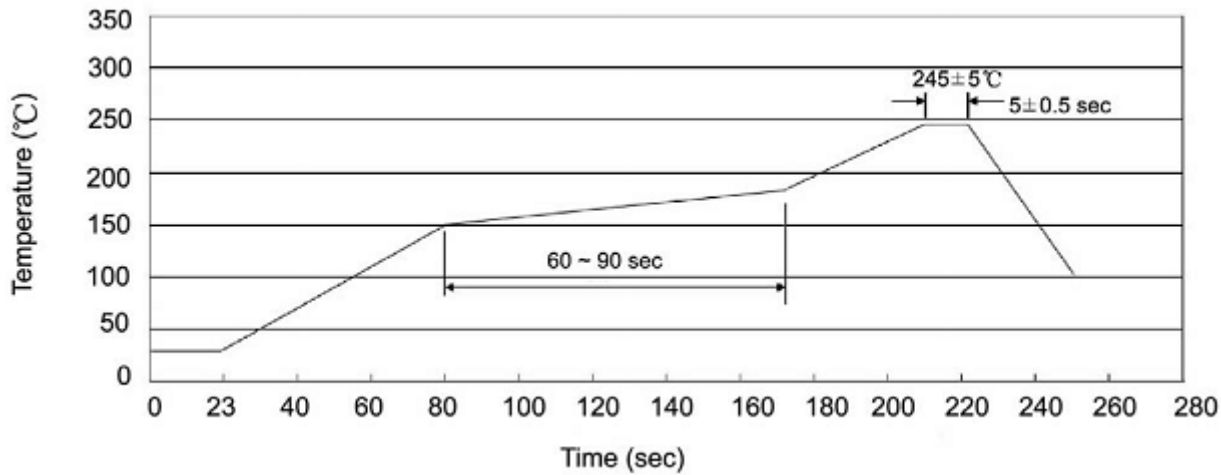
Note:

G： HF Product Code

J6： Product Type Code

A：  $h_{FE}$  Classifications Symbol Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



- 说明：

  - 1、预热温度 25 ~ 150℃，时间 60 ~ 90sec;
  - 2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;
  - 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10℃/sec.
- Note:

  - 1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec.
  - 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
  3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5℃      时间：10±1 sec.      Temp.:260±5℃      Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	8	240,000	7" ×8	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices